Produktkatalog

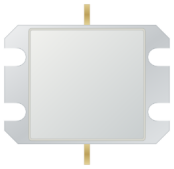
RF-Leistungstransistoren

RF-Leistungstransistoren wandeln Vorspannung und RF-Ansteuerung in nutzbare Ausgangsleistung einer Verstärkerstufe um. Sie werden in Senderketten, Leistungsmodulen, industriellen RF-Quellen und Hochleistungsprüfständen eingesetzt.



Produkte: 11

Revision: 10 · Revisionsdatum: 2026-11-11



LCT-5700-7100-PS51T

5700–7100 MHz GaN Intern angepasster Leistungstransistor — PSAT 51 dBm (typisch)

5700–7100 MHz; PSAT 51 dBm (typisch); Leistungsverstärkung 11 dB (typisch); PAE 45 % (typisch).

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 5700; Maximum: 7100; Wert: 5700–7100; Einheit: MHz

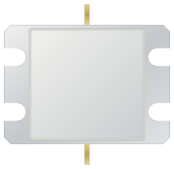
Sättigungsausgangsleistung: Minimum: 50.5; Typisch: 51; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Minimum: 10.5; Typisch: 11; Einheit: dB

Leistungsaddierte Effizienz: Minimum: 40; Typisch: 45; Einheit: %

TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.4] V; Pin = 40 dBm; D = 10%; PW = 100 µs

Produktdetails Produktdatenblatt



LCT-2700-3500-PS56p5T

2700–3500 MHz GaN Intern angepasster Leistungstransistor — PSAT 56.5 dBm (typisch)

2700–3500 MHz; PSAT 56.5 dBm (typisch); Leistungsverstärkung 13.5 dB (typisch); PAE 55 % (typisch).

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 2700; Maximum: 3500; Wert: 2700–3500; Einheit: MHz

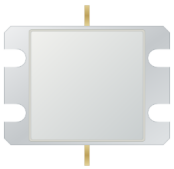
Sättigungsausgangsleistung: Minimum: 56; Typisch: 56.5; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Minimum: 13; Typisch: 13.5; Einheit: dB

Leistungsaddierte Effizienz: Minimum: 50; Typisch: 55; Einheit: %

TA = +25 °C; VDS = 44 V; VGS ∈ [-4, -2] V; IDS = (0.2–0.5) IDSS; PW = 300 µs; D = 10%

Produktdetails Produktdatenblatt



LCT-5300-5900-PS56p5T

5300–5900 MHz GaN Intern angepasster Leistungstransistor — PSAT 56.5 dBm (typisch)

5300–5900 MHz; PSAT 56.5 dBm (typisch); Leistungsverstärkung 12.5 dB (typisch); PAE 45 % (typisch).

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 5300; Maximum: 5900; Wert: 5300–5900; Einheit: MHz

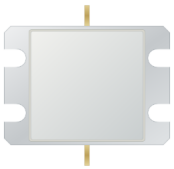
Sättigungsausgangsleistung: Minimum: 56; Typisch: 56.5; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Minimum: 12; Typisch: 12.5; Einheit: dB

Leistungsaddierte Effizienz: Minimum: 40; Typisch: 45; Einheit: %

TA = +25 °C; VDS = 40 V; VGS ∈ [-4, -2] V; IDS = (0.2–0.5) IDSS; PW = 10 µs; D = 1%

Produktdetails Produktdatenblatt



LCT-2700-3900-PS48p5T

2700–3900 MHz GaN Intern angepasster Leistungstransistor — PSAT 48.5 dBm (typisch)

2700–3900 MHz; PSAT 48.5 dBm (typisch); Leistungsverstärkung 12.5 dB (typisch); PAE 50 % (typisch).

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 2700; Maximum: 3900; Wert: 2700–3900; Einheit: MHz

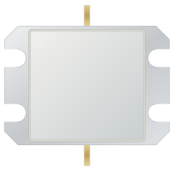
Sättigungsausgangsleistung: Minimum: 48; Typisch: 48.5; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Minimum: 12; Typisch: 12.5; Einheit: dB

Leistungsaddierte Effizienz: Minimum: 45; Typisch: 50; Einheit: %

TA = +25 °C; VDS = 24–28 V; VGS ∈ [-4, -2] V; IDS = (0.2–0.5) IDSS

Produktdetails Produktdatenblatt



LCT-2700-3500-PS53p5T

2700–3500 MHz GaN Intern angepasster Leistungstransistor — PSAT 53.5 dBm (typisch)

2700–3500 MHz; PSAT 53.5 dBm (typisch); Leistungsverstärkung 13.5 dB (typisch); PAE 65 % (typisch).

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 2700; Maximum: 3500; Wert: 2700–3500; Einheit: MHz

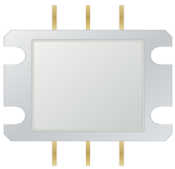
Sättigungsausgangsleistung: Minimum: 53; Typisch: 53.5; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Minimum: 13; Typisch: 13.5; Einheit: dB

Leistungsaddierte Effizienz: Minimum: 60; Typisch: 65; Einheit: %

TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-4, -2] V; Pin = 40 dBm; D = 10%; PW = 100 µs

Produktdetails Produktdatenblatt



LCT-2300-3900-PS50T

2300–3900 MHz GaN Intern angepasster Leistungstransistor — PSAT 50 dBm (typisch)

2300–3900 MHz; PSAT 50 dBm (typisch); Leistungsverstärkung 12 dB (typisch); PAE 50 % (typisch).

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 2300; Maximum: 3900; Wert: 2300–3900; Einheit: MHz

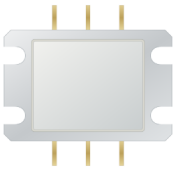
Sättigungsausgangsleistung: Minimum: 49; Typisch: 50; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Minimum: 11; Typisch: 12; Einheit: dB

Leistungsaddierte Effizienz: Minimum: 45; Typisch: 50; Einheit: %

TA = +25 °C; VGS ∈ [-4, -2] V; VDS = 24–28 V; IDS = (0.2–0.5) IDSS

Produktdetails Produktdatenblatt



LCT-2600-3700-PS49T

2600–3700 MHz GaN Intern angepasster Leistungstransistor — PSAT 49 dBm (typisch)

2600–3700 MHz; PSAT 49 dBm (typisch); Leistungsverstärkung 13 dB (typisch); PAE 50 % (typisch).

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 2600; Maximum: 3700; Wert: 2600–3700; Einheit: MHz

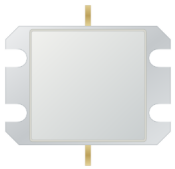
Sättigungsausgangsleistung: Minimum: 48; Typisch: 49; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Minimum: 12; Typisch: 13; Einheit: dB

Leistungsaddierte Effizienz: Minimum: 45; Typisch: 50; Einheit: %

TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.2] V; Pin = 36 dBm; CW

Produktdetails Produktdatenblatt



LCT-8500-9600-PS51T

8500–9600 MHz GaN Intern angepasster Leistungstransistor — PSAT 51 dBm (typisch)

8500–9600 MHz; PSAT 51 dBm (typisch); Leistungsverstärkung 9 dB (typisch); PAE 38 % (typisch).

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 8500; Maximum: 9600; Wert: 8500–9600; Einheit: MHz

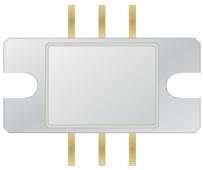
Sättigungsausgangsleistung: Minimum: 50; Typisch: 51; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Minimum: 8; Typisch: 9; Einheit: dB

Leistungsaddierte Effizienz: Typisch: 38; Einheit: %

Vd = +28 V; Vg = -3 V; PW = 100 µs; D = 10%; Pin = 42 dBm

Produktdetails Produktdatenblatt



LCT-2000-6000-PO45p51T

2000–6000 MHz GaN Intern angepasster Leistungstransistor — Pout 45.51 dBm @ 6000 MHz (typisch)

2000–6000 MHz; Referenz-Ausgangsleistung 45.51 dBm (typisch); Leistungsverstärkung 19.51 dB (typisch); Drain-Wirkungsgrad 39.82 % (typisch) @ 6000 MHz.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 2000; Maximum: 6000; Wert: 2000–6000; Einheit: MHz

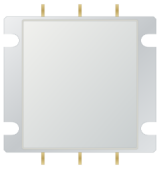
Referenz-Ausgangsleistung: Typisch: 45.51; Einheit: dBm; Hinweise: f = 6000 MHz

Leistungsverstärkung: Typisch: 19.51; Einheit: dB; Hinweise: f = 6000 MHz

Drain-Wirkungsgrad: Symbol: ηD; Typisch: 39.82; Einheit: %; Hinweise: f = 6000 MHz

TA = +25 °C; VDS = 28 V; IDQ = 1.3 A; CW; f = 6000 MHz; Pin = 26 dBm

Produktdetails Produktdatenblatt



LCT-700-6200-PS49T

700–6200 MHz GaN Intern angepasster Leistungstransistor — PSAT 49 dBm @ 6000 MHz (typisch)

700–6200 MHz; Sättigungsausgangsleistung 49 dBm (typisch); Leistungsverstärkung 7 dB (typisch); Drain-Wirkungsgrad 35 % (typisch) @ 6000 MHz.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 700; Maximum: 6200; Wert: 700–6200; Einheit: MHz

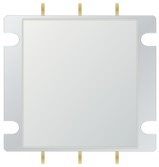
Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Typisch: 49; Einheit: dBm; Hinweise: f = 6000 MHz

Leistungsverstärkung: Typisch: 7; Einheit: dB; Hinweise: f = 6000 MHz

Drain-Wirkungsgrad: Symbol: ηD; Typisch: 35; Einheit: %; Hinweise: f = 6000 MHz

TA = +25 °C; VDS = 28 V; IDQ = 1 A; CW; f = 6000 MHz

Produktdetails Produktdatenblatt



LCT-2000-6200-PO50p1T

2000–6200 MHz GaN Intern angepasster Leistungstransistor — Pout 50.1 dBm @ 6000 MHz (typisch)

2000–6200 MHz; Referenz-Ausgangsleistung 50.1 dBm (typisch); Leistungsverstärkung 8.6 dB (typisch); Drain-Wirkungsgrad 52.4 % (typisch) @ 6000 MHz.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 2000; Maximum: 6200; Wert: 2000–6200; Einheit: MHz

Referenz-Ausgangsleistung: Typisch: 50.1; Einheit: dBm; Hinweise: f = 6000 MHz

Leistungsverstärkung: Typisch: 8.6; Einheit: dB; Hinweise: f = 6000 MHz

Drain-Wirkungsgrad: Symbol: ηD; Typisch: 52.4; Einheit: %; Hinweise: f = 6000 MHz

TA = +25 °C; VDS = 28 V; IDQ = 0.5 A; CW; f = 6000 MHz; Pin = 41.5 dBm

Produktdetails Produktdatenblatt

Dokumenthinweis

Spezifikationen können revidiert werden. Prüfen Sie vor der Designfreigabe mit LCRF den aktuellen Dokumentstand und die produktspezifischen Anforderungen. Das freigegebene Angebot und die Auftragsunterlagen definieren die gelieferte Konfiguration.